

第8回 筑波大学パワーエレクトロニクス未来技術研究会

UTOP - University of Tsukuba Forum on Power Electronics Tomorrow

テーマ「SiC パワーデバイス適用上の課題とその対策」

日時 2020年2月21日(金) 13:15~17:05

場所 筑波大学 東京キャンパス文京校舎 1階 134 講義室

東京都文京区大塚 3-29-1 (東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅下車徒歩5分程度)



Map

費用 参加費 1,000 円 (資料代を含む・別途意見交換会 3000 円・学生はどちらも無料)

プログラム

座長: 筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 准教授 磯部 高範

13:15~13:20 ご挨拶 SiC アライアンス会長 京都大学 名誉教授 松波 弘之

13:20~13:30 筑波大学パワーエレクトロニクス研究室の近況ご紹介
筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 教授 岩室 憲幸

13:30~13:55 【講演】2019 年度筑波大学パワエレ研発表-1
「SBD 内蔵 SiC トレンチ MOSFET (SWITCH-MOS)の負荷短絡耐量特性の解析」
筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 修士2年 大川 雅貴

13:55~14:20 【講演】2019 年度筑波大学パワエレ研発表-2
「負荷短絡耐量の無いデバイスを使用可能にする Z ソースインバータ」
筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 修士2年 高嶋 薫

14:20~15:10 【講演】「SiC パワーデバイスのモジュール化による高速スイッチング動作と放熱」
大阪大学大学院 電気電子情報工学専攻 教授 舟木 剛

15:10~15:25 休憩

座長: 筑波大学 数理物質科学研究科 パワーエレクトロニクス研究室 准教授 矢野 裕司

15:25~16:15 【講演】「SiC デバイス応用機器の開発動向と今後の課題・期待」
三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 パワーエレクトロニクス技術部門 主管技師長 大井 健史

16:15~17:05 【講演】「Si-IGBT を SiC で置き換える際の課題
パワーサイクル、信頼性、振動、そして製品付加価値」
株式会社日立パワーデバイス ビジネスマネジメント本部 主管技師長 齊藤 克明

17:30~19:30 意見交換会 (林野会館)

参加登録 SiC アライアンスホームページ

<http://www.sicalliance.jp/>

2月7日(金) 締切



参加登録

主催



筑波大学 数理物質系

共催



一般社団法人 SiC アライアンス

後援



パワーエレクトロニクス学会

協賛

